

AO4302-AOS美国万代-N沟道-品牌代理-原装进口-AO4302

产品名称	AO4302-AOS美国万代-N沟道-品牌代理-原装进口-AO4302
公司名称	深圳市九亨电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强广场D座10J
联系电话	0755-25322132 15889361220

产品详情

一般说明
AO4302结合了先进的沟槽MOSFET
技术采用低阻抗封装提供
极低的RDS (ON)。该器件非常适合负载开关
和电池保护应用。
产品摘要 AO4302
VDS 30V
ID (VGS = 10V) 23A
RDS (ON) (VGS = 10V) <4m
RDS (ON) (VGS = 4.5V) <5m
ESD保护
100% UIS经过测试

100% Rg测试

AO4302

A.使用安装在1in2 FR-4板上的器件和2oz测量 R_{JA} 的值。铜，在 $I_A = 25^\circ\text{C}$ 的静止空气环境中。该

任何给定应用中的值取决于用户的特定电路板设计。

B.功耗PD基于 $T_J(\text{MAX}) = 150^\circ\text{C}$ ，使用 10s 结全环境热阻。

C.重复额定值，脉冲宽度受结温 $T_J(\text{MAX}) = 150^\circ\text{C}$ 的限制。额定值基于低频率和占空比来保持

initial $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。

D. R_{JA} 是从结到引线 R_{JL} 的热阻抗与导致环境的总和。

E.使用 $<300\ \mu\text{s}$ 脉冲，占空比0.5%获得图1至图6中的静态特性。

F.这些曲线基于结全环境的热阻抗，该阻抗是通过安装在1in2 FR-4板上的器件测得的。

2盎司铜，假设结温 $T_J(\text{MAX}) = 150^\circ\text{C}$ 。SOA曲线提供单脉冲额定值。

规格FET 类型N 沟道技术MOSFET (金属氧化物) 漏源电压 (V_{DS}) 30V 电流 - 连续漏极 (I_D) (25°C 时) 23A (T_a) 驱动电压 ($R_{DS\text{ On}}$, $R_{DS\text{ On}}$) 4.5V, 10V 不同 I_D , V_{GS} 时的 $R_{DS\text{ On}}$ (值) 4 毫欧 @ 20A, 10V 不同 I_D 时的 $V_{GS(\text{th})}$ (值) 2.3V @ 250 μA 不同 V_{GS} 时的栅极电荷 (Q_g) (值) 63nC @ 10V V_{GS} (值) $\pm 20\text{V}$ 不同 V_{DS} 时的输入电容 (C_{iss}) (值) 3470pF @ 15V FET 功能- 功率耗散 (值) 3.6W (T_a) 工作温度 $-55^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ (T_J) 安装类型 表面贴装 供应商器件封装 8-SOIC 封装/外壳 8-SOIC (0.154", 3.90mm 宽)

深圳市九亨电子有限公司自成立以来，本着诚信原则，以顾客至上，互利互惠的经营理念，立足深圳，面向国际市场，赢得广大客户一致的信赖和好评。公司主要代理AOS美国万代，主要提供功率MOSFET，电源IC和瞬态电压抑制器TVS，以满足当今先进的电子系统和消费类电子对于电源的复杂的要求。我们相信，一个成熟的现代企业拥有的不仅仅是高质的产品，公司以科学现代的管理，充分利用高科技技术的发展，将“顾客至上，互利互惠”的理念贯穿于产品销售、服务的始终。欢迎广大客户来电咨询！